

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук**

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
главного научного сотрудника – заведующего лабораторией
в лаборатории Электроники полупроводников с большой энергией связи.
Вакансия VAC_26773

Тематика исследований

Исследования и разработки в области физических основ и технологий широкозонных полупроводников, включая процессы роста, диффузии политипизма, с целью получения оптоэлектронных приборов на основе SiC, GaN и AlN.

Трудовая деятельность

Осуществление научного руководства конкретными темами исследований согласно государственному заданию и планам НИР по утверждённым целевым программам, а также подготовка и подача заявок на новые проекты в рамках базового бюджетного и целевого финансирования; руководство работой сотрудников, выполняющих эти исследования, и обеспечение выполнения ими правил внутреннего распорядка в учреждении. Непосредственное участие в выполнении исследований: разработка методов решения наиболее сложных научных проблем; обоснование направлений новых исследований и разработок, предложений к программам и планам научно-исследовательских работ; организация разработки новых научных проектов; координация деятельности соисполнителей работ; обеспечение анализа и обобщения полученных результатов, предложение сферы их применения. Осуществление подготовки научных кадров, участие в повышении их квалификации.

Особенности трудовой деятельности: главный научный сотрудник – заведующий лабораторией Электроники полупроводников с большой энергией связи несет полную материальную ответственность за имущество, закрепленное за лабораторией, а также работает со сведениями, составляющими государственную тайну по ф. 3.

С целью обеспечения поддержания уровня исследований в лаборатории Электроники полупроводников с большой энергией связи на уровне, не ниже достигнутого в настоящее время, при оценке кандидатов комиссия будет исходить из следующих минимальных требований к квалификации кандидатов.

- Наличие учёной степени доктора физико-математических наук
- Общее количество научных, конструкторских и технологических произведений, в том числе: опубликованных статей в научных журналах не менее 330 шт., выпущенной конструкторской и технологической документации не менее 50 шт..
- Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе: учтенных в государственных информационных системах не менее 31 шт., имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в РФ не менее 10 шт., имеющих правовую охрану за пределами Российской Федерации не менее 11 шт.
- Число публикаций, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования: Scopus не менее 244 шт..
- Опыт научной работы: не менее 25 лет
- Опыт научно-организационной работы: не менее 13 лет.

За последние 5 лет руководство не менее чем 6 грантами отечественных и зарубежных научных фондов, в том числе не менее чем 1 проектом РНФ и не менее чем 4 международными грантами.

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы

- личный листок по учету кадров;
- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- сведения о научной (научно-организационной) работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса;
- характеристика с последнего места работы.

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, заместителю директора ФТИ им. А.Ф. Иоффе А.Б. Подласкину, телефон для справок: (812)2927196.

Настоящие требования к кандидатам и перечень необходимых документов опубликованы на веб-сайте ФТИ им. А.Ф. Иоффе (<http://www.ioffe.ru>).